

RÄTTELSER

Rättelse till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1749 av den 7 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 och upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

(Europeiska unionens officiella tidning L 421 av den 14 december 2020)

1. På sidan 94 ska punkt 2B206.c.1 och 2B206.c.2 lyda som följer:
 - "1. Innehåller 'laser', och
 2. kan under minst 12 timmar inom ett temperaturintervall av ± 1 K (± 1 °C) runt standardtemperaturen och vid standardtryck bibehålla alla följande egenskaper:
 - a) En 'upplösning' över hela skalområdet som är lika med eller bättre än 0,1 μm , och
 - b) en 'mätosäkerhet' som är lika med eller bättre (mindre) än $(0,2 + L/2\ 000)$ μm (L är den uppmätta längden i mm)."
2. På sidan 142 ska punkt 3B001.f.3–3B001.g lyda som följer:
 - "3. Utrustning som är speciellt konstruerad för att tillverka masker och som har allt av följande:
 - a) Den använder avlänkade fokuserade elektron-, jon- eller 'laser' strålar, och
 - b) har något av följande:
 1. En halvvärdesbredd på under 65 nm och bildplacering på mindre än 17 nm (medelvärde + 3 sigma).
 2. Används inte.
 3. Misspass på andra lagret på mindre än 23 nm (medelvärde + 3 sigma) på masken.
 4. Utrustning som är konstruerad för bearbetning med hjälp av direkta skrivmetoder och som har allt av följande:
 - a) Den använder avlänkade fokuserade elektronstrålar, och
 - b) har något av följande:
 1. En minsta strålstorlek på högst 15 nm.
 2. Misspass på mindre än 27 nm (medelvärde + 3 sigma).
 - g) Masker eller mastermasker som är konstruerade integrerade kretsar som specificeras i avsnitt 3A001."
3. På sidan 160 ska punkt 5E001.d–5E001.e.2 lyda som följer:
 - "d) 'Teknik' enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för 'utveckling' eller 'produktion' av förstärkare i form av 'monolitiska integrerade mikrovågskretsar' ('MMIC'-förstärkare) som är speciellt konstruerade för telekommunikation och som uppfyller något av följande:

Teknisk anmärkning:

I samband med avsnitt 5E001.d kan parametern maximal topp effekt (peak saturated power output) på ett produktdatablad också anges som uteffekt, mättad topputeffekt, maximal uteffekt, utgångstoppeffekt, eller maximal topputeffekt (PEP).

 1. De är specificerade för frekvenser som överstiger 2,7 GHz men inte 6,8 GHz med en 'relativ bandbredd' som är större än 15 % och som har något av följande:
 - a) En maximal topp effekt på mer än 75 W (48,75 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 2,7 GHz men inte 2,9 GHz.
 - b) En maximal topp effekt på mer än 55 W (47,4 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 2,9 GHz men inte 3,2 GHz.
 - c) En maximal topp effekt på mer än 40 W (46 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 3,2 GHz men inte 3,7 GHz.
 - d) En maximal topp effekt på mer än 20 W (43 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 3,7 GHz men inte 6,8 GHz.

2. De är specificerade för frekvenser som överstiger 6,8 GHz men inte 16 GHz med en 'relativ bandbredd' som är större än 10 % och som har något av följande:
 - a) En maximal toppeffekt på mer än 10 W (40 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 6,8 GHz men inte 8,5 GHz.
 - b) En maximal toppeffekt på mer än 5 W (37 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 8,5 GHz men inte 16 GHz.
 3. De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 3 W (34,77 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 16 GHz men inte 31,8 GHz, och med en 'relativ bandbredd' på över 10 %.
 4. De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (-70 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 31,8 GHz men inte 37 GHz.
 5. De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 37 GHz men inte 43,5 GHz, och med en 'relativ bandbredd' på över 10 %.
 6. De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 31,62 mW (15 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 43,5 GHz men inte 75 GHz, och med en 'relativ bandbredd' på över 10 %.
 7. De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 10 mW (10 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 75 GHz men inte 90 GHz, och med en 'relativ bandbredd' på över 5 %.
 8. De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (-70 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 90 GHz.
- e) 'Teknik' enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för 'utveckling' eller 'produktion' av elektroniska enheter och kretsar, som är speciellt konstruerade för telekommunikation och som innehåller komponenter tillverkade av 'supraledande' material, speciellt konstruerade för drift vid temperaturer under den 'kritiska temperaturen' för åtminstone en av dess 'supraledande' beståndsdelar, och som är försedda med något av följande:
1. Strömomkoppling i digitala kretsar med användning av 'supraledande' grindar och där produkten av grindfördröjningstiden per grind (i sekunder) och effektförlusten per grind (i watt) är mindre än 10^{-14} J.
 2. Frekvensval för alla frekvenser med användning av resonanskretsar med Q-värden som överstiger 10 000."
4. På sidan 175 ska punkt 6A002.a-6A002.a.1.d lyda som följer:
- "a. Optiska detektorer enligt följande:
1. 'Rymdkvalificerade' halvledardetektorer enligt följande:

Anmärkning: I avsnitt 6A002.a.1 inbegrips 'fokalplansmatriser' i halvledardetektorer.

 - a) 'Rymdkvalificerade' halvledardetektorer med samtliga följande egenskaper:
 1. En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 300 nm.
 2. En känslighet vid våglängder över 400 nm på mindre än 1 % av den maximala känsligheten.
 - b) 'Rymdkvalificerade' halvledardetektorer med samtliga följande egenskaper:
 1. En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 900 nm men inte 1 200 nm.
 2. En 'svarstidskonstant' på högst 95 ns.
 - c) 'Rymdkvalificerade' halvledardetektorer med en maximal känslighet inom våglängdsområdet som överstiger 1 200 nm men inte 30 000 nm.
 - d) 'Rymdkvalificerade' fokalplansmatriser' med mer än 2 048 element per matris och en maximal känslighet i våglängdsområdet som överstiger 300 nm men inte 900 nm."

5. På sidan 179 ska punkt 6A002.b–6A002.f lyda som följer:

”b. 'Monospektrala bildsensorer' och 'multispektrala bildsensorer' som konstruerats för fjärranalystillämpningar och med någon av följande egenskaper:

1. Ett lokalt (IFOV = Instantaneous-Field-Of-View) bildfält på mindre än 200 µrad (mikroradianer), eller
2. Specifikt konstruerade för arbete inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 30 000 nm och som har alla följande egenskaper:
 - a) De lämnar bildinformationen i digital form.
 - b) Någon av följande egenskaper:
 1. Är 'rymdkvalificerad'.
 2. Konstruerade för att fungera i luftburna applikationer med något annat än kisel som detektormaterial och de har ett IFOV (IFOV = Instantaneous-Field-Of-View) på mindre än 2,5 mrad (milliradianer).

Anmärkning: Avsnitt 6A002.b.1 omfattar inte 'monospektrala bildsensorer' med en största känslighet i ett våglängdsområde som överstiger 300 nm men inte 900 nm och som endast innehåller någon av följande icke-'rymdkvalificerade' detektorer eller icke-'rymdkvalificerade' 'fokalplansmatriser':

1. Laddningskopplade enheter (CCD) som inte är konstruerade eller modifierade för att åstadkomma 'laddningsförstärkning', eller
2. Komplementära metalloxidhalvledareheter (CMOS) som inte är konstruerade eller modifierade för att åstadkomma 'laddningsförstärkning'.

c. Bildförstärkarutrustning som 'direkt ger en synlig bild', och som har något av följande:

1. Bildförstärkarrör som specificeras i avsnitt 6A002.a.2.a eller 6A002.a.2.b.
2. 'Fokalplansmatriser' som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.
3. Halvledardetektorer som specificeras i avsnitt 6A002.a.1.

Teknisk anmärkning:

Med 'direkt ger en synlig bild' avses en bildförstärkarutrustning som visar en synlig bild till den mänskliga observatören utan att bilden omvandlas till en elektronisk signal för att visas på tv-skärm. Bilden kan inte spelas in eller lagras fotografiskt, elektroniskt eller på annat sätt.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.c omfattar inte utrustning enligt följande, som innehåller andra än GaAs- eller GaInAs-fotokatoder:

- a) Industriella eller civila inbrottslarm, rörelsedetektorer för trafik- eller industriändamål eller räkneselement.
- b) Medicinsk utrustning.
- c) Industriell utrustning för kontroll, sortering eller analys av materialets egenskaper.
- d) Flamdetektorer för industriella brännugnar.
- e) Utrustning som särskilt konstruerats för laboratoriebruk.

d. Särskilda komponenter som används för att understödja optiska givare enligt följande:

1. 'Rymdkvalificerade' lågtemperaturkylare (cryocoolers).
2. Icke 'rymdkvalificerade' lågtemperaturkylare (cryocoolers) med en kylkälla som är kallare än 218 K (–55 °C) och som har
 - a) ett slutet system med en MTBF eller MTTF (medeltid mellan fel eller medeltid till fel) som överstiger 2 500 timmar,
 - b) självreglerande minikylare, typ Joule-Thomson, med en cylinder(ytter)diameter under 8 mm.
3. Optiska fibrer som kan användas som givare, speciellt tillverkade antingen genom sin sammansättning eller struktur eller modifierade genom ytbeläggning för att bli akustiskt, termiskt, elektromagnetiskt, tröghets- eller strålningsmässigt känsliga.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.d.3 omfattar inte inkapslade optiska fibrer som kan användas som givare, speciellt konstruerade för tillämpningar för avkänning av borrhål.

- e. Används inte.
- f. 'Utläsningsskretsar' ('ROIC') särskilt konstruerade för 'fokalplansmatriser' specificerade i avsnitt 6A002.a.3.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.f omfattar inte 'utläsningsskretsar' särskilt konstruerade för civila biltillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En 'utläsningsskrets' ('ROIC') är en integrerad krets konstruerad för att ligga under eller vara sammanfogad med en 'fokalplansmatris' och som används för avläsning (dvs. extrahering och registrering) av signaler som skapas av detektorelementen. En 'utläsningsskrets' avläser åtminstone laddningen från detektorelementen genom att extrahera laddningen och tillämpa en multiplexeringsfunktion på ett sätt som behåller detektorelementens relativa geografiska positions- och orienteringsinformation för bearbetning inom eller utanför 'utläsningsskretsen'.
